PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number.

09-022669

(43)Date of publication of application: 21.01.1997

(51)Int.CI.

H01J 29/89 802B 1/11 H01J 9/20 H01J 29/88 H04N 5/72

(21)Application number

07-168753

(71)Applicant .

MATSUSHITA ELECTRON CORP

(22)Date of filing .

04.07.1895

(72)Inventor

HAYAMA HIDEKAZU

ishiai kei20

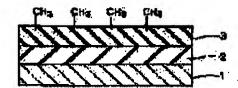
YAMAMURA MASAHIRO

(54) IMAGE DISPLAY DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED. To provide an Image display device to be applied to a picture tube or the like, which is provided with a reflection lowering function and a charge preventing function without hindering the characteristic of image at a high resolution and at a high contrast and which can prevent the finger print and the adhesion of spotting, by forming a conductive high refraction index thin film in the glass side and forming a water repellent low refractive index thin film outside of the conductive high refractive index thin film.

SOLUTION. As an inner layer 2, a transparent and conductive high refractive index thin film at 1.85 of refractive index is evenly formed at 85nm of film thickness (t1) on the outer surface of a face panel glass 1 at 1.54 of refractive index, and as an outer layer 3, a low refractive index thin film at 1.42 of refractive index, which has methyl group, is evenly fermed at 99nm of film thickness (t1) on the surface of the inner layer 2. Optical film thickness of the high refractive index thin film as the inner layer 2 and the low refractive index thin film as the outer layer 3 are set at 140nm at 1/4 of the wavelength at 560nm at a high luminosity among the outside light.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.08.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Oate of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(Date of extinction of right)

Copyright (C), 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出關公園番号

特開平9-22669

(43)公開日 平成9年(1997)1月21日

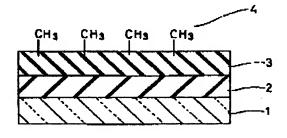
				-		
(51) Int.Cl.*	建 別紀 号	广内推进进 号	FI		,	技術表示個所
H01J 29	/ 83		HOLJ 2	9/89		
G02B 1	/11		9	9/20	A	
HOJJ 9	/20		2	9/88		
	/88		H04N	5/72	A	
	/72		G 0 2 B	1/10	A	
•••••			有空間求	朱爾宋 清泉	項の数5 OL	(全 6 貞)
(21) 出國祭号	特里平7 -168753	特惠平7 -168753		000005843		
() ()	****			松下電子工業	株式会社	
(22) 出題日	平成7年(1995)7	平成7年(1995)7月4日		大阪府英橋市	學町1番1号	
	1,441 1 11		(72) 完明者	羽山 秀和		
					等町1番1号:	接下電子工學
				株式会社内		
			(72)発明者	石合 包二		
				大阪府高橋市	华町1条1号	松下電子工業
				株式会社内		
			(72) 発明者	山村 昌大		
				大阪府高橋市	率町1番1号	松下電子工業
				株式会社内		
			(74)代理人	井寒士 独内	宣章 (外1	4 G)
	`					

(54) 【免明の名称】 画像表示整備及びその製造方法

(57)【安約】

【源組】 カラス側に導電性の高屈折半薄膜が形成され、その外層に強水性低屈折率薄膜が積削された反射的止膜が形成されていることにより、高解像度、高コントラストの画像の特性を損なうことなく。反射低減硬能と沿電防止機能を備え、かつフィンガ・ブリント及びシミ跡の付着を防止する受像費などに優れた画像表示装置を提供する。

【解決手段】 和新率154のフェースパネルガラス1の外表面上に、両周折平傳極透明の内層ととして、導電性で開新率が1.65. 腹厚1、が85nmの均 輝腰を形成し、前記内層2の表面上に低層折率薄膜の外層3として、開新率が1.42. 腹厚1、が99nmのメチル基を行する均 薄膜が形成され、内層2の高層折平薄膜がよび外層3の低層折平薄膜は、それぞれの光学膜厚が外光のうち視感度の高い液長である560nmに対してその液長の1/4もある140nmとする。



(2)

将閉Ψ9-22669

【特許調本の範囲】

ガラス製フェースパネル表面に反射防止 【請求項1】 膜を備えた画像表示装置において、ガラス側に導電性の 高屈折率課題が形成され、その外層に撥水性低屈折率簿 庭が積層された反射防止阪が形成されていることを特徴 とする画像公示仮置。

【清水収2】 撥水性低屈折率薄膜が、メチル整合有酸 化ケイ菜からなる請求項1に配載の画像表示装置。

【湖水頂3】 撥水性低屈折率薄膜が、屈折率】 4~ 1. 5の範囲、原厚70~150ヵmの範囲である請求 10 項】に記載の画像表示装置。

【湖水項4】 海電性の高屈折率薄膜が、酸化ケイ系、 酸化チタン、酸化スズ、酸化アンチモンから選ばれる少 なくとも一つの酸化物を含み、かつ屈折率が1. 6~ 項1に記載の画像表示英置。

【請求項5】 ガラス製フェースパネル表面に反射防止 膜を備えた画像表示装置の製造方法において、ガラス製 フェースパネル上に導電性の商屈折率薄膜を形成し、次 にアルキルシリケート蛋合体をアルコール系溶液に溶解 20 した存成にメチルトリメトキシシランをが加した混合格 液を坐布したのら加熱することにより、液水性低層抗率 強腰を形成することを特徴とする画像表示英型の製造方 몺.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【知明の属する技術分野】本発明は、外光反射低減の機 能を備えた受像性またはブラズマディスプレイパネル特 の画像表示装置及びその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】室内照明灯等による外光が、受保管など の面像表示技器のガラス製フェースパネルの外表面で反 別すると、再生画像が非常に見つらくなる。また、フェ ースパネルの外表面に静電気が蓄積すると、フェースパ ネルにてみが付むしやすくなるばかりでなく、感覚の危 険が生じる場合かある。これを解决する手段として、例 えば特別475 67432号公権には、フェースパネル 外表面上に酸化スズおよび酸化ケイ素を含む揮発性溶液 を回転像布しかつ乾燥させて得た第1層上に、酸化ケイ たる第2層を得っ焼き付けを行うことによって得られた。 複合膜の干渉作用で、フェースパネル外表面における光 反射率を約1、5%以下にすると同時に、帯電防止作用 を得ることができる方法が開示されている。

[0003]

【私明が解決しようとする疎組】しかし、面配従来の情 成では、平滑版であるため、表示画像の解像度やコント ラストか劣化するという問題はないか、反面、フィンガ ープリントとよばれる指紋跡が目だら易く、それを除去 することが困難である。また、水拭きを行った場合に水 50 傑能と帯電防止機能を備え、かつフィンガーソリント及

適か長時間残るようなことがあると、よく光るシミ跡が 残るなどの問題点を有していた。

2

【0004】また、最外表面に凹凸を設けてフィンガー ブリントの付着を防ぐ方法もあるが、凹凸により蛍光面 から発せられる光が散乱し解像度が低下したり、外光の 散乱反射光のためコントラストが低ドするなどの問題が

【UUU5】本発明は、耐配従来の問題を解決するた め、髙解像度、高コントラストの画像の特性を損なうに となく、反射低減機能と帯電防止機能を備え、かつフィ ンガープリント及びシミ跡の付着を防止する受保管など に侵れた画像表示装置及びその製造方法を提供すること を目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた め、本発明の画像表示装置は、ガラス製フェースパネル **設面に反射防止膜を備えた画像表示装置において、ガラ** ス側に導電性の高屈折平薄鏡が形成され、その外層に敬 水性低屈折半薄膜が積層された反射防止膜が形成されて いることを特徴とする。前記において導定性とは、それ 目体で10'~10"Q/□(前機抵抗またはそのほか の表示により、本発明でいう導電性の範囲を定義してく たさい。)の範囲の電気抵抗をいう。また本発明でいう 撥水性とは、水との接触角か40°以上をいう。

【0007】前記において撥水性低屈折邪御腕か、メチ ル基含有酸化ケイ素からなることが好ましい。また可能 において、撥水性低屈折半薄膜が、屈折半1.4~1. ましい。

【0008】また前記において、海軍性の高屈折半導膜 が、酸化ケイ素、酸化チタン、酸化スズ、酸化アンチモ ンから遠ばれる少なくとも…つの酸化物を含み、かつ屈 析率1 8~2.0の範囲、原序7~130nmの範囲 であることか好ましい。

【ロロロ9】次に本発明の画像表示装置の製造方法は、 カラス製フェースパネル表面に反射防止膜を備えた画像 **表示装置の製造方法において、ガラス製フェースパネル** 上に導電性の心屈折率薄膜を形成し、次にアルキルシリ ケート承告体をアルコール系密徴に密解した俗佼にメチ 者を含む弾発性格視を回転性命しかつ乾燥させて天山層 40 ルトリメトキシシランを添加した混合格視を塗布したの ち加熱することにより、撥水性低加折率海線を形成する ことを特徴とする。

(0010)

【允明の実施の形盤】前記した本発明の構成によれば、 カラス製フェースパネル表面に反射防止酸を備えた画像 表示核遺において、ガラス側に違憲性の高屈折率体膜が 形成され、その外層に撥水性低屈折率薄膜が積層された 反射防止膜が形成されていることにより、高解像度、高 コントラストの画像の特性を初なうことなり、反射仏域

特別49-22889

びシミ跡の付着を防止する受像者などに催れた画像表示 後属を提供できる。すなわち、表面が撮水性になってい るのでフィンカーフリントの試き取り件が良くなり、ま た水拭さなどを行っても水溜が残りにくくなるととも に、カルシウム等不能物と反応しやすいシラノール基 (-SiOH)に代わり、反応の超とりにくいメチルシ リル廷 (一SiCH,) となっていろため、たとえ水資 が残ってもカルシウム等の不純物の付着によるシミ跡が 残りにくい。

【UUII】また、酸化ケイ染にメチル基を傾飾させる 10 ととで低屈折率層の屈折率を酸化ケイ素のみの場合に比 べて低くすることができる。ところで、炎而に入射する 外光に対する反射率の最低値Rは、高屈折率薄膜もよひ 低風折率薄膜それぞれの光字膜厚(実際の膜厚に肌折率 を乗じた頃) が外光の所定の波長入の1/4の場合。下 記式(数1)で表されるか、この式(数1)から明らか なように低屈折率層の屈折率を低くすることにより反射 低減効果が改善できる。

[0012]

【数1】

$$R = \left(\frac{n_{s} \cdot n_{1}^{2} - n_{0} \cdot n_{h}^{2}}{n_{h} \cdot n_{1}^{2} + n_{0} \cdot n_{h}^{2}}\right)^{2}$$

【0013】なむ、ここで、n、はフェースパネルの屈 折斗、n、は低屈好率層の屈折半、n、は高屈折率層の 屈折平、11。は空気の屈折率である。次に本発明方法に よれば、効率良く合理的に画像表示装置を提供できる。 [0014]

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を用いて 説明する。図2は本発明の一実施例として、本発明を用 いた受像音の全体図を示している。受像管21は、その **内部に閃示しない蛍光面を行するフェースパネル 1 と**ク ァンネル22より構成されている。ファンネル22に は、高汗電源からアノート電圧を供給するためのアノー・ ドボタン23が埋数されている。ファンネル22の後端 部には、内部に図示しない電子銃を有するネック部と4 が設けられている。このネック部の最後端部より、図示 しないステムビンを介して電子銃の各電極に所定の駆動 の境界部の外側には、電子銃から発射された電子ビーム を蛍光面上で走査するための傾向ヨーク26か設けられ ている。また25はソケット、27は補強パンドであ

【U015】次に、関1は本発明の一実施例である受像 晋の要部拡大断面図である。ガラス稀板1の表面に導電 性の高屈折率再膜2と、その表面に強水性低屈折率再膜 3が韓層され、樹水性低配折率薄膜3にはメチル基ケか 存在している。以下製造工程を説明する。

(1)商屈折平海腮形成工程

屈折率1.54のフェースパネルガラス1の外表面上 に、内層2として酸化ケイ素、酸化チタンおよびアンチ モンをドーフした酸化スズからなる透明な導電性の屈折 率が1. 85の高旭折平薄贋(頂厚t. が85 nm)を 形成する。この高屈折率薄膜の均一薄膜を得るために、 チトラエチルシリケートとテトラブチルチクネートをエ タノール溶媒中、塩酸存在下で加水分解、および共重合 させた組織化平均高径約10 mmのアンチモンをドープ した酸化スズ微粒子を均一に分散させた榕板をスピンコ -・ト法で塗布し、約80°Cに加熱して内層2とする。

(2) 低屈折率移膜形成工程

次に前記高屈折率薄膜の表面上に外層3としてメチル基 を含む酸化ケイ末からなる透明な風折率が1.42の低 屈折筆宿聴か健厚t、か98nmの均一得頭が形成され ている。この質を得るために、テトラエチルシリケート をエタノール俗塚中、鬼酸存在下で加水分解、および重 台させた溶板にメチルトリメトキシシランとして、たと えば東レ・タウコーニング・シリコーン株式会社製のS Z8070(製品名)を、デトラエチルシリケートとの 20 重量比がメチルトリメトキシシラン: テトラエチルシリ **グートー』:↓の割合で添加した溶液をスピンコートは** で塗布し、60℃に加熱乾燥した後、400℃にて焼成

【0018】以上のようにして内臓2と外贈3から成る 2層の反射防止腕を形成する。内隔2の高層折率存職も よび外層3の低層折率薄膜は、それぞれの光学膜障が外 光のうち視感度の高い波長であるλ=560nmに対し てその収長の(1/4)人である140mmとなってい

【0017】この反射防止膜の外局当は図3に示すよう な化字構造となっており、表面に切れるメテル基4によ り水の接触角が80°の撥水性となり、汚れの付着を防 止することができる。

【0018】水瓜水を潤下して24時間放置した水シミ 付着テストの結果比較としての従来の外層が酸化ケイ素 のみで形成されている場合は、改固に付着した水ンミが 発生し、晒し布(木棉布)で空気をや水気きを行っても 水シミを除去することはできなかったが、本発明表施例 の受像性では水鍋が表面の撥水性により水溝が残らず水 電圧が印加される。ファンネル部22とネック部21と 40 シミは発生しなかった。また、強制的に水滴を残存させ た場合もホシミか付着するが、軽く晒し市で水状ををす ろことで除去することができた。

> 【0019】また、従来の反射防止験では、水状きを行 った場合に行く光るシミ跡が残っていたが、本発明の天 旋例では、このようなシャ跡は生しなかった。これは、 従来の反射防止膜では、水の中のカルシュウム等の不軽 物が反射防止酸の低屈折平移駆である酸化ケイ素(Si U。)の順中に概存している水酸量(SIOII)と化 学的に結合して表面に強く付着し、干渉作用による反射 50 低減の触以の関係が崩れ、青く光るシミ跡となっていた。

(4)

特別平9-22669

と考えられるのに対し、本発明では、腰厚のパランスが 崩れないためと考えられる。

【0020】参考として図4に外層3が酸化ケイ素のみ で形成されている場合の化学構造を示すが、表面に水酸 基5が現れており、このために表面は水の接触円が5° の親水性となり、また、水に含まれているカルシュウム 写の不動物かCの水酸基と結合して強固に付着する。本 来は内暦20両屈折導膜、外暦3の低屈折率傳展のそれ ぞれの光学膜厚か、外光の所定の波段 入の 1/4であ り、図5に示す反射低減の模式図に表すように所定の波 10 シシランが揮発して胰腺にハラッキが生じやすく、シメ 氏の外光6に対してフェースパネルと内層2の界面での 反射光7、内層2と外層3の界面での反射光8および外 層3の表面での反射光8の位相がちょうど打ち消し台う ように重なることによる干渉作用による各反射光の合成 光10の反射低減がなされているのに対して、外層3の 表面にカルシウムなどの不純物による薄膜が形成された 形となり隠耳の関係が崩れ、図6の水シミ部の反射光の 模式図に示すように不純物による薄膜11の腰厚によっ ては、所定の波長の外光8に対してフェースパネルと内 層2の界面での反射光? 内層2と外層3の界面での 20 にメチルトリメトキンシランの投入量がメチルトリメト 反射光8 および不純物表面での反射光9 のそれぞれ の反射光の位相が強め合うように重なって、合成光10 が強まり光る水シミが生じる。

することで低屈折毛層である外層3の屈折率を従来の 1、47から1、42に低くするととでき、前述の反射 半の最低値を表す式(1)からわかろように、反射防止 効果として反射率の最低値を従来のし、UV%からU. 4 3%に改造することかできる。このような低屈折率の 薄膜を得ることのできる材料としては、ファ化マグネシ ウム (Mg F₄) か知られているが、フッ化マグネシワ ムを含む酸化ケイ系で薄膜を形成した場合は、薄膜の強 度が弱いことやファ化マグネシウムの微粒子の乱反射に より白っぱくなり、透明性が低下するという問題点があ

る。--方、本発明のメチル基を含む酸化ケイ素の薄膜 は、むしろ酸化ケイ素のみの薄膜よりも膜強度は増加 し、しかも非常に透明な薄頼を得ることができる。

【0022】尚、メテル葢を修飾した酸化ケイ素薄膜を 得るために、上記実施例のメチルトリストキシシッンの 投入の代わりにトリスチルストキンシランやジスチルジ ストキンシランを投入することも考えられるが、トリメ チルメトキシンランはテトラエチルシリケートとの反応 か不充分な場合は、薄膜の形成過程でトリメチルメトキ チルジメトキシシランはそれ自体が月己重縮合をおこし てシリコンオイル化し、塗液がはしいて薄膜形成ができ ないという問題がある。

【0023】上記実施例ではメチルトリメトキシシラン をテトラエチルシリケートとの意識比がメチルトリメト キシシラン: テトラエチルシリケートロ1:1の割合で 添加したが、表しのメテルトリストキンシランとテトラ エチルシリケートの重量比と水の接触角、上層の屈折 串、水シミの皮合むよび反射低減効果の関係に示すよう キシシラン:テトラエチルシリケートの重量比で2 5 よりも多い場合に後水性および屈折率の改善が認められ る。ただし、メチルトリメトキシシランの投入量がメチ ルトリストキシシラン:テトラエチルシリケートの重量 比で2:1よりも多くなろとメチルトリメトキシシマン が充分にテトラエチルシリケートと及応せず、加熱や焼 成時にメデルトリメトキシシランが揮発して膜厚が一定 せず膜厚側御が困難になる。このためメチルトリメトキ シシランの役人量はメチルトリメトキシシラン:テトラ 30 エチルシリケートの重量比で2:5から2:1が通りで

[0024]

【表1】

7

2003-08-06

15:21

(5)

特別 49-22889

J9619791995/ \$1/576959-1 電量比	不心 素敬用	上編 明哲平	水ン! の配合	及射性性均差 (反射率、分)
0: 1	2.	1 47	A	1. 90 A
1.100	5.	1. 47	4	1 00 A
1. 20	5-	1 47	٨	1. 00 A
1 - 10	5.	1, 45	×	U. 87 A
1: 5	15.	1. 45	Δ	0 75 C
p · 5	40.	1. 44	٥	0. 65 O
3: 5	80.	1 42	٥	0. 49 🗘
4: S	70	1 42	0	0 43 🗢
1. 1	80.	1 42	۵	0. 43 👲
2 · 1	80.	1. 42	0	0 43 6

【()()25】上記実施例では、塗布法としてスピンコー 20 により、再生画像か見づらくなることを防ぐとともに画 トを用いたかディップコートやスプレーコートなどの一 いては実用的な無強度が得られる↓50℃からメチル基 が分解しない500でまでの範囲で療成を行うとともで 53.

【ひり26】また、内層ととして酸化かイ素、酸化チタ ンおよびアンチモンをドーブした酸化スズからなる透明 毎萬辰を用いたが、アンチモンをトーブした酸化スズの 代わりにインシュウムティンオキサイドを用いても良 く、CVD広により形成される酸化スズ膜を用いること 30 國の化学構造図 eres.

【0027】また、外光の所定の波長として視感度の高 い580 nmの場合を説明したか、これに限るものでは ない。尚上記支施例は受除管について説明したか、PD P. LCD等他の画像表示装置に用いても同様の効果を 有する。この場合、フェースガラスパネルの材質の違い により、屈折率が上配実施例と異なる時は、反射防止腺 を構成する各層の順序を遊貨調整することにより同様の 効果を得ることかできる。

(0028)

【発明の効果】本発明の画像表示領置は フィンカーフ リントか付着しても軽く水状きずることによりフィンガ ・ブリントを除去することができる。また、水シミに対 しても水シミか付着しにくく、また仮に付着しても呼く 水拭きすることで除工でき、強固に付着することはなっ く。安定した反射防止効果が実現できる。

【0029】さらに、本発明の画像表示装置は外光によ る支盾反射率はその最低値が0、65~0、43%であ り、優れた反射防止効果が得られ、室内順明などの外先 像のコントラストを向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図』】 本発明の…実施例である画像表示装置の要部 扩大断面图

【図2】 本発明の一実施例である受像性の全体構成を 示すの模式的側面図

【図3】 本知明の一段施例の画像表示契証の反射防止 膜における外層の化学構造図

【図4】 従来の画像表示製造の反射防止既における外

【図5】 反射低級の模式図

【図6】 ホシミ部の反射光の模式図

【符号の説明】

- 1 フェースパネルカラス
- 2 Ps (2)
- 3 外層
- 4 メチル基
- 5 水胶丛
- 人射光
- 40 7. 7 , 8, 8 , 9, 9 反明光
 - 10 合成光
 - 11 不純物による薄原
 - 21 受除官
 - 22 ファンネル
 - 23 アノートポタン
 - 24 ネック部
 - 25 ソケット
 - 26 偏向ヨーク
 - ピア 油酸パンド

(6)

特別中9-22869

